



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种镁合金低频脉冲磁场辅助半连续铸造结晶器及其应用

文献类型: 专利

作者 罗天骄, 杨院生, 冯小辉, 李应举 and 付俊伟

发表日期 2011-12-28

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本发明属于金属材料制备领域,具体涉及一种镁合金低频脉冲磁场辅助半连续铸造结晶器及其应用。结晶器外壳的顶部设置结晶器上盖,结晶器外壳和结晶器上盖的中心孔位置设有结晶器内套,结晶器外壳和结晶器上盖之间形成冷却水槽,冷却水槽中设置励磁线圈,结晶器外壳的外侧设置与冷却水槽相通的进水口,结晶器内套上开有与冷却水槽相通的二次冷却水喷孔。结晶器外壳和上盖为不锈钢,结晶器内套为4XXX系铝合金,且结晶器内套的上口高出上盖上表面,上口和下口间呈喇叭状。本发明用于镁合金的半连续铸造,利用其产生的脉冲电磁力作用于结晶器内部镁合金熔体,使熔体产生强制对流,细化粗大枝晶,增加形核率,镁合金半连续铸棒晶粒细化效果明显。

公开日期 2011-12-28

语种 中文

专利申请号 CN102294445A

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/67249>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 罗天骄, 杨院生, 冯小辉, 李应举 and 付俊伟. 一种镁合金低频脉冲磁场辅助半连续铸造结晶器及其应用. 2011-12-28. **GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
244	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。